EPITA	/	InfoS3
--------------	---	--------

NOM : Prénom :

Décembre 2021 Groupe :



Partiel Electronique - CORRIGE

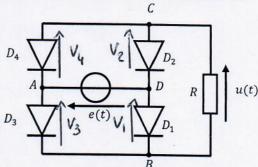
Les calculatrices et les documents ne sont pas autorisés. Le barème est donné à titre indicatif.

Réponses exclusivement sur le sujet. Si vous manquez de place, vous pouvez utiliser le verso des pages.

Exercice 1. Redresseur double alternance (6 points)

Soit le montage ci-contre :

- e(t) est une source de tension variable et on utilisera dans une premier temps le modèle idéal pour les diodes.
 - a) Durant l'alternance positive (e(t) > 0), quelle(s) D_3 diode(s) est (sont) conductrice(s)? Justifiez votre réponse.



Comme, dans une disde; le courant:

- circule de l'anode vers la cathode

... descend les potentiels (dipôle récepteur)
alor, D3 et D2 sont conductrices.

b) Quelle est alors l'expression de u ?

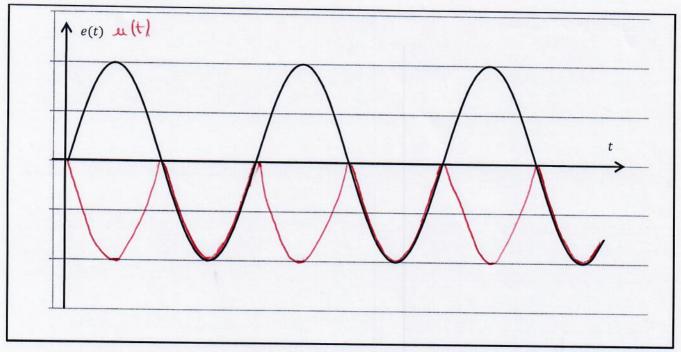
Loi des mailles: $e(t) - V_3 + u(t) - V_2 = 0 = u(t) = -e(t) + V_c + V_5$ Comme les disoles sont soliales, $V_2 = V_3 = 0$ (De et D3 conductions) = u(t) = -e(t)

c) Durant l'alternance négative (e(t) < 0), quelle(s) diode(s) est (sont) conductrice(s) ? Justifiez votre réponse.

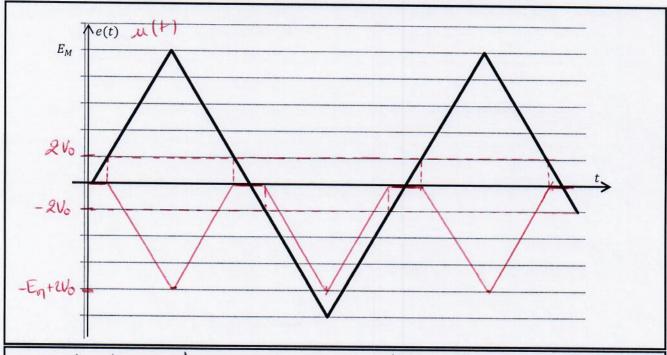
De la vience façon pri à la pression d, on trouve que De et De sont conductices.

d) Quelle est alors l'expression de u ?

doi des mailles: e(t) + V4 - u(t) + V, =0 = nult/= e(t)+V/+V4. Comme V1 = V4 =0 (cf. b), u(t) = e(t). e) Tracer alors u(t).



f) On remplace désormais les diodes par leur modèle à seuil. Tracer l'allure de u(t), en justifiant votre réponse. On notera V_0 la tension de seuil de chacune des diodes et on supposera que la valeur maximale E_M de e(t) est telle que $E_M > 2$. V_0 .



Il fant maintenant tenir compte de la tension de seuil des diodes. [elt] doit donc au mettr être égale à 26 pour que les tensions ours bornes des 2 diodes conductices de chapue alternance puissent être égales à Vo. Si - 200 (elt) (200, our moins 3 diodes sont bloquées et u(t)=0

Exercice 2. Polarisation (6 points)

On considère le montage suivant.

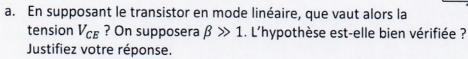
On donne:

$$R_C = 1k\Omega$$
, $R_E = 1k\Omega$, $V_{CC} = 10V$,

votre réponse!

 $\beta = 150$, $V_{BE} = 0.7V$ si la jonction Base-Emetteur est passante.

1. On souhaite obtenir un courant $I_C = 4,65 \text{ mA}$.



da loi dus mailles donne: $V_{CC} = RcI_{C} + V_{CE} + ReI_{E}$ 6r, en mode linéaire, $I_{C} = \beta I_{B}$ et $I_{E} (\beta + i)I_{B}$ 2 $\beta . I_{B}$

= TE ? Ic.

Gua done: Ver = Vec - (Re+RE) Ic

A.D: Vce = 10 - 2 x 4,65 = 0,7V. >0 = 2 transister fonctionne bien en mode l'héair.

b. Quelle est la valeur de la résistance R_B qui permet d'obtenir ce courant I_C . On considérera que $\beta+1\approx\beta$ pour l'application numérique. N'oubliez pas de justifier

La loi des mailles donne: $V_{CC} = R_B T_B + V_{BE} + R_E T_E$ Comme $T_E = (\beta + A) T_B$, on a: $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - (\beta + 1) R_E T_B}{T_B} \text{ and } T_B = \frac{T_C}{\beta}$ AN: $R_B = \frac{10 - 0.7 - 1.4.65}{4.65} \text{ 150} \left(\cos(\beta + 1) T_B \approx T_B \approx T_C\right)$ $R_B = 150 \text{ k.C.}$

2. Quelle est la valeur minimale de la résistance R_B qui assure une polarisation du transistor dans sa zone de fonctionnement linéaire. On considèrera que $\beta+1\approx\beta$. N'oubliez pas de justifier votre réponse !

Le transistor reste polarise dans sa zone de fonction-
vernent linéaire tout pue
$$V_{CE} > 0$$
.

Gr: $V_{CE} = V_{CC} - (R_{C} + R_{E}) I_{C}$ cou $\beta + 1 \approx \beta = \pi I_{E} \approx I_{C}$.

En fonctionnement linéaire, $I_{C} = \beta I_{B}$ et, on a

 $I_{B} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B} + \beta R_{E}}$ (Loi dus mailles + $I_{E} = (\beta + 1) I_{B} \propto \beta I_{B}$)

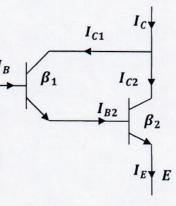
 $R_{B} > \beta$. $(R_{E} + R_{C}) \frac{V_{CC} - V_{BE}}{V_{CC}} - \beta R_{E}$.

AN: $R_{B} > 129 \text{ k.2} = \pi R_{Bmin} = 129 \text{ k.2}$.

Exercice 3. Montage Darligton (3 points)

On considère le montage ci-contre.

 eta_1 étant le coefficient de transfert du courant de base (aussi appelé Gain en courant) du transistor de gauche et eta_2 celui du transistor de droite, déterminer le gain en courant eta du transistor équivalent, en fonction de eta_1 et eta_2 . On considèrera que eta_1 et eta_2 sont très grands devant 1 et on supposera les deux transistors polarisés dans leur zone de fonctionnement linéaire. Justifiez votre réponse.



Rq: Commencez par exprimer I_C en fonction de I_B .

$$T_{c} = T_{c_{A}} + T_{c_{2}}.$$

$$T_{c_{A}} = \beta_{1} T_{B} \quad ; \quad T_{c_{2}} = \beta_{2}. T_{B_{2}} \quad ; \quad T_{B_{2}} = T_{g} + T_{c_{1}}$$

$$= (\beta_{1} + 1)T_{B}$$

$$= \sum_{c} T_{c} = \beta_{1} T_{B} + \beta_{2} (\beta_{A} + A) T_{B} = \beta_{1} T_{B} + \beta_{2} \beta_{1} T_{B}$$

$$= \beta_{1} (\beta_{2} + 1) T_{B} = \beta_{1} \beta_{2} T_{B} = \beta_{2} \beta_{2}.$$

$$= \beta_{1} \beta_{2} T_{B} = \beta_{2} \beta_{2} T_{B} = \beta_{3} \beta_{2}.$$

Exercice 4. QCM (5 points - Pas de point négatif)

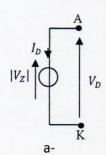
- 1. Le dopage permet de diminuer la conductivité du semiconducteur.
 - a. VRAI

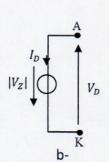
6 FAUX

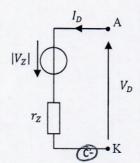


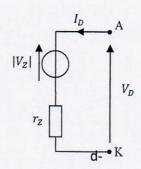
http://www.hector-bd.com/

2. Par quoi remplace-t-on la diode Zéner lorsqu'elle est passante en inverse si on utilise le modèle réel?



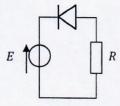






Soit le circuit ci-contre, dans lequel on considère la diode idéale (interrupteur) (Q3&4)

3. Que vaut la tension aux bornes de R si E=10V, $R=100\Omega$.



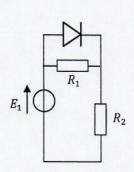
4. Que vaut la tension V_{AK} aux bornes de la diode si E=0.5~V, $R=1\mathrm{k}\Omega$.

$$(b) -0.5 V$$

$$d - 0.7 V$$

Soit le circuit ci-contre, dans lequel on modélise la diode par son modèle à seuil (source de tension idéale) avec $V_0=0.6V$. (Q5&6)

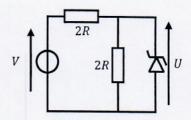
- 5. Choisir l'affirmation correcte si $E_1=1~V$, $R_1=100\Omega$, et $R_2=500\Omega$:
 - a- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 0,8 mA
 - **b** La diode est bloquée et la tension à ses bornes est égale à $\frac{1}{6}V$.
 - c- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 1A.
 - d- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 2mA.



6. Choisir l'affirmation correcte si $E_1=10V$, $R_1=100\Omega$, et $R_2=50\Omega$:

- a- La diode est bloquée et la tension à ses bornes est égale à $\frac{20}{3}V$.
- b- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 100 mA
- c- La diode est passante et le courant qui la traverse vaut 5A.
- \bigcirc La diode est passante et le courant qui la traverse est égal à 182 mA.

Soit le circuit ci-contre dans lequel V est une tension pouvant prendre n'importe quelle valeur réelle. On utilisera le modèle réel de la diode et on notera V_0 la tension de seuil en direct, r_D , la résistance interne de la diode en direct, V_Z ($V_Z>0$) , la tension de seuil Zéner et r_Z , la résistance interne de la diode en inverse. (Q7&8)



7. Pour quelles valeurs de V la diode Zéner est-elle bloquée ?

a-
$$-2.V_z \le V \le 2.V_0$$

$$c-V_z \le V \le V_0$$

(b)
$$-2.V_0 \le V \le 2.V_Z$$

$$d-V_0 \le V \le V_Z$$

8. Quelle est l'expression de U quand la diode est passante en inverse ?

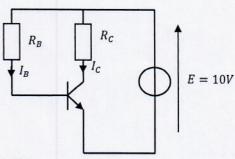
c-
$$U = \frac{r_D}{2r_D + 2R} \cdot V + \frac{2R}{2r_D + 2R} \cdot V_0$$

b-
$$U = \frac{r_Z}{2r_Z + 2R} \cdot V - \frac{2R}{2r_Z + 2R} \cdot V_Z$$

d-
$$U = \frac{r_D}{2r_D + 2R} \cdot V - \frac{2R}{2r_D + 2R} \cdot V_0$$

Soit le circuit ci-contre (Q9&10)

On considère le cahier des charges suivant : $I_C=20~mA$, $V_{CE}=5V$, et on prend un transistor ayant les caractéristiques suivantes : $\beta=100$, $V_{BE}=0.7V$ si la jonction Base-Emetteur est passante.



9. Que vaut V_{BC} ? :

$$a - 0.6V$$

$$b - 5.7V$$

$$(d-4,3)$$

10. Que vaut R_C ? :

a. $2,5k\Omega$

c. 25Ω

(b) 250Ω

d. 750Ω